

Study on defect characterization of Ge gate stacks using deep-level transient spectroscopy

温, 偉辰

<https://hdl.handle.net/2324/4110526>

出版情報 : Kyushu University, 2020, 博士 (工学), 課程博士
バージョン :
権利関係 :

氏 名	温 偉辰
論 文 名	Study on defect characterization of Ge gate stacks using deep-level transient spectroscopy (DLTS 法を用いた Ge ゲートスタックの欠陥評価に関する研究)
論文調査委員	主 査 九州大学 教授 服部 励治 副 査 九州大学 教授 中島 寛 副 査 九州大学 システム情報科学研究所 准教授 佐道 泰造 副 査 九州大学 准教授 王 冬

論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨

本論文は、Ge ゲートスタック中の欠陥を定量的に評価するための手法を確立すると共に、種々のゲートスタックに対して界面欠陥と絶縁膜中の欠陥を高精度に定量評価したものであり、半導体工学に寄与するところが大きい。よって、本論文は博士(工学)の学位に値するものと認められる。